

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

DIALOG(R)File 347:JAPIO
(c) 1998 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03242326
LIQUID CRYSTAL ELECTROOPTIC DEVICE

PUB. NO.: 02-217826 [JP 2217826 A]
PUBLISHED: August 30, 1990 (19900830)
INVENTOR(s): YAMAZAKI SHUNPEI
APPLICANT(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD [470730] (A Japanese
Company or Corporation), JP (Japan)
APPL. NO.: 01-326553 [JP 89326553]
FILED: December 15, 1989 (19891215)

ABSTRACT

PURPOSE: To enable development even to a liquid crystal display by forming field-effect semiconductor devices IGF, resistances, and capacitors on a substrate, specially, an insulating substrate.

CONSTITUTION: On one electrode 22 which is coupled electrically to a semiconductor 12, the other electrode 24 and one electrode 32 of a 2nd liquid crystal capacitor 31 which is coupled with the electrode 24a are coupled through an opening 25, and a counter electrode 27 made of a transparent electrode is provided corresponding to the electrode 32 by pinching a dielectric of liquid crystal 26. Thus, the IGF capacitors, and resistor or the plane panel of the liquid crystal display as a sandwich structure are provided on the substrate 1 at the same time, they are covered from above so as to prevent light from leaking in a 0 state when the IGFs 10 are irradiated with light from above, and one electrode 3 of a picture element is provided. Consequently, a solid-state display device for a plane television replacing a cathode-ray tube can be manufactured.

⑫ 公開特許公報(A) 平2-217826

⑤ Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成2年(1990)8月30日

G 02 F 1/136
G 09 G 3/36
H 01 L 27/12
29/784

5 0 0

7370-2H
8621-5C
7514-5F

A

8624-5F

H 01 L 29/78

3 1 1 A

審査請求 有 発明の数 1 (全7頁)

⑭ 発明の名称 液晶電気光学装置

⑯ 特 願 平1-326553

⑰ 出 願 昭56(1981)1月9日

⑱ 特 願 昭56-1768の分割

⑲ 発 明 者 山 崎 舜 平 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

⑳ 出 願 人 株式会社半導体エネルギー研究所 神奈川県厚木市長谷398番地

明 細 書

1. 発明の名称

液晶電気光学装置

2. 特許請求の範囲

1. 絶縁ゲイト型電界効果半導体装置に液晶表示装置と電荷蓄積用キャパシタとが直列に接続された構造であって、前記絶縁ゲイト型電界効果半導体装置上に前記液晶表示装置の一方の電極が設けられた液晶電気光学装置。

2. 特許請求の範囲第1項において、液晶表示装置の一方の電極は、絶縁ゲイト型電界効果半導体装置へ光が照射されないように設けられたことを特徴とする液晶電気光学装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は基板上にたてチャンネル型の積層型の絶縁ゲイト型半導体装置を設けた液晶電気光学装置に関する。

さらに本発明は基板上の積層型の絶縁ゲイト型電界効果半導体装置のソースまたはドレインに連結してキャパシタを有せしめた複合半導体装置を

設けた液晶電気光学装置に関する。

本発明はかかる複合半導体装置をマトリックス構造に基板上に設け、液晶表示型のディスプレイ装置を設けることを特徴としている。

本発明は表面型の固体表示装置を設ける場合、平行なガラス板内に電極を設けてこの電極間に液晶を注入した液晶表示装置が知られている。しかしこの場合この表示部の絵素数は20~200までが限界であり、それ以上とする場合はこの表示部より外にとり出す端子が絵素の数だけ必要となってしまうため全く実用に供することができなかった。このためこの表示部を複数の絵素とし、それをマトリックス構成させ、任意の絵素を制御してオンまたはオフ状態にするにはその絵素に対応した電界効果半導体装置(IGFという)を必要としていた。そしてこのIGFに制御信号を与えてそれに対応した絵素をオンまたはオフさせたものである。

この液晶表示部はその等価回路としてキャパシタ(以下Cという)にて示すことができる。この

ため1とCとを例えば 2×2 のマトリックス構成(40)せしめたものを第1図に示す。

第1図においてマトリックス(40)はひとつのIGF(10)とひとつのC(31)によりひとつの絵素を構成させている。これを行に(51)、(51')とビット線に連結し、他方ゲイトを連結して列(41)、(41')を設けたものである。

すると、例えば(51)、(41)を"1"とし、(51')、(41')を"0"とすると(1,1)番地のみを選択してオンとし、電氣的にC(31)として等価的に示される液晶表示を選択的にオン状態にすることができる。本発明は同一基板上にデコーダ、ドライバーを構成せしめるため、他の絶縁ゲイト型半導体装置(50)および他のインバータ(60)、抵抗(70)を同一基板上に設けることを目的としている。

かくすることにより本発明をその設計仕様に基づいて組合わせることによりブラウン管に代わる平面テレビ用の固体表示装置を作ることができた。

さらにカリキュレータ用の表示装置は $10^3 \sim 10^5$ ヶの絵素を要すればよく、TV用には $10^4 \sim 10^5$ 個

モルファス)構造の珪素半導体を用いている。本発明においてはセミアモルファス半導体(以下SASという)を中心として示す。このSASに関して本発明人の発明になる特許願例えば特願昭55-143885(55.10.15出願)(セミアモルファス半導体)、特願昭55-122786(55.9.4出願)(半導体装置)、特願昭55-026388(55.3.3出願)(セミアモルファス半導体)にその詳細な実施例が示されている。

さらに第2図においてフォトリソグラフィ技術によりS3を選択的に除去し、さらにこのS3をマスクとしてS2を除去した。このフォトリソグラフィの終点をみるため絶縁または半絶縁膜(以下単に絶縁膜という)(13)は窒化珪素をして設けた。

さらにその厚さは5~30Åのうすさであり、第1の半導体をプラズマ照射にされたアンモニア雰囲気さらにすることにより成就した。次にこの絶縁膜(13)を化学的に除去した後第2図(B)を得た。

このS3の上にこの後に形成された絶縁膜をさらに厚く作るため、あらかじめLPCVD法(減

例えば $10^3 \times 10^3$ 個の絵素を同一基板上に設け、かつその周辺に必要なデコーダおよびドライバーを同時に形成させたIGF、インバータ、抵抗を用いて作ればよいことがわかる。

本発明にかかるシステムを作るために必要な積層型のIGFおよびそれに液晶表示部を連結させた絵素に関するものである。

第2図は本発明の積層型IGFのたての断面図およびその製造工程を示したものである。

図面において絶縁基板例えばガラスまたはアルミナ基板上にP+またはN+型の導電型を有する第1の半導体(2)(以下単にS1という)トンネル電流を流しうる厚さの絶縁または半絶縁膜(3)第2の真性またはNまたはP型の半導体(4)(以下単にS2という)、第1の半導体と同一導電型を有する第3の半導体(5)(以下単にS3という)を積層して設けた。

この半導体は基板上にシランのグロー放電法を利用して室温~500℃の温度にて設けたもので、非晶質(アモルファス)または半非晶質(セミア

圧気相法)により $0.3 \sim 1 \mu$ の厚さに酸化珪素膜を形成しておいてもよい。またこのS3上にMo、Wを $0.2 \sim 0.5 \mu$ さらにその上にSiO₂を $0.3 \sim 1 \mu$ とさせてS3の導電率を向上させることはマトリックス化に有効であった。

また第2図(B)において側面は基板(1)表面上に垂直に形成してもよいが、台形上にテーパエッチをしてさらに積層されるゲイト電極の段差部での段切を除去することは効果的であった。

さらに第2図(C)に示される如く、フォトリソグラフィ技術によりS1を任意の所定形状を形成した。図面ではこのため(11)にて基板表面が露光させた。

さらにこの後このS1、S2、S3の表面全体に絶縁膜(6)を形成した。この絶縁膜は13.56MHz~2.45GHzの周波数の電磁エネルギーにより活性化して酸素または酸素と水素との混合気体雰囲気にて100~700℃に浸して酸化して形成した。

さらにLPCVD法により窒化珪素またはリンガラスを形成させた多層構造としてもよい。

するとS 2 (14)の側周辺にはゲイト絶縁物(16)としてこの絶縁物(16)が形成され、S 1、S 3の表面はアイソレーション用被膜として形成させることができた。

さらに(D)に示される如く、第3のフォトリソグラフィ技術によりS 1 (12)に対し電極穴(10)をS 3 (15)に対し電極穴(11)を形成しゲイト電極に連絡する金属または半導体層を再度積層した。

次に第4のフォトリソグラフィ技術によりこの膜を選択的にエッチングして、ゲイト電極(17)をゲイト絶縁物(16)、(16')と2方向に設けて作り、同時にS 1 (12)、S 3 (15)より電極穴を介して他部のIGF、キャパシタ、抵抗へ基板表面または絶縁物(6)上に密接して配線させた。

第2図(D)のたて断面図のA-A'を横方向よりみると第2図(E)として示すことができる。番号はそれぞれ対応させている。

本発明の半導体は主としてSASを用い、その中の不對結合手の中和用に水素を用いており、かつ基板と半導体、電極リードが異種材料であり、

アモルファス珪素が電子 $0.1 \sim 10 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 、ホールは $0.01 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ 以下に比べて $10 \sim 10^2$ 倍も長いことを考えると、本発明の半導体装置にマイクロクリスタル構造を有するSASを用いたことはきわめて重要なことである。

さらに本発明のIGFにおいて、電子移動度がホールに比べて単結晶の3倍よりも大きく $5 \sim 100$ 倍もあるためNチャネル型とするのがきわめて好ましかった。

そのためS 2には不純物を表面部に添加しない真性半導体はN型であるためこれをP型として用いた。

第3図は他の本発明のIGFのたて断面図およびその製造工程を示したものである。

第3図(A)において基板(1)上にSASの珪素膜をS 1 (2)として形成させた。さらにフォトリソグラフィ技術により選択エッチングを行ない、基板(1)の一部(11)を露呈させた。

次にこのSASを結晶化するための光(レーザ)アニール、熱アニールまたはこれらを併用して

それらの熱膨張によるストレスを少なくするため、すべての処理を $300 \sim 600^\circ\text{C}$ 以下好ましくは 300°C 以下でするとよかった。

またゲイト電極(17)をS 1、S 3と同一導電性の半導体およびそれにMo等の金属を二重構造とした多層配線構造でもよい。

かくしてソースまたはドレインをS 1 (12)、チャネル形成領域(9)、(9')を有するS 2 (14)、ドレインまたはソースをS 3 (15)により形成せしめ、チャネル形成領域側面にはゲイト絶縁物(16)、(16')その外側面にゲイト電極(17)を設けた積層型のIGF(10)を作ることができた。

この発明においてチャネル長S 2 (14)の厚さで決められ、ここでは $0.05 \sim 0.5 \mu$ とした。それはSASの移動度が単結晶とは異なりその $1/5 \sim 1/100$ しかないため、チャネル長を短くしてIGFとしての特性を助長させることにある。

SASは電子のバルク移動度が $100 \sim 500 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ と $1/3 \sim 1/10$ であるのに対し、ホールのそれは $5 \sim 100 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ と $1/5 \sim 1/100$ である。しかしそれに

このSASを単結晶または多結晶構造に変成させた。加熱温度は基板材料での熱ストレスを防ぐため、 700°C 以下にさせた。

このS 1 (2)は基本的にはS 2、S 3とエッチングレートが変わればよい。このためS 1はPまたはN型の酸素または窒素が添加されて SiO_{2-x} ($0.5 < x < 2$)、 $\text{Si}_3\text{N}_{4-x}$ ($1 < x < 4$)の化学量論を有する真性または半絶縁性を有する半導体であってもよい。

第3図(B)に示す如く、この後この上面にS 2 (4)を真性、N型またはP型でさらにS 1と同一の導電性にS 3 (5)をPまたはN型に積層して同一反応炉により形成せしめた。

さらに第3図(C)に示す如く、このS 2 (4)、S 3 (5)を概略同一形状に選択的に他部を除去して形成し、S 2 (14)、S 3 (15)をS 1 (12)上に設けた。この後このS 1、S 2、S 3上表面を酸化して絶縁膜(6)として設けた。この時S 2 (14)の側周辺はゲイト絶縁膜(16)として設けられ、他部はアイソレーション膜として設けた。

次に第3のフォトリソグラフィ技術を用いて電極穴またはコンタクト部(7)、(8)を用いてその全上表面に半導体または導体の膜を設けた。この膜を第4のフォトリソグラフィ技術により選択的に除去してS1(12)にはその他部への連結電極リード(22)を、S3(15)にはコンタクト(7)を介して同様の電極、リードを設け、またS2(14)の側周辺のチャネル形成領域(9)、(9')の側面のゲイト電極(16)、(16')上にはゲイト電極(17)を構成した。

このようにしてソースまたはドレインをS1(12)によりチャネル形成領域(9)、(9')をS2(14)により、ドレインまたはソースをS3(15)により構成せしめた。ゲイトはゲイト絶縁物(16)、(16')とゲイト電極(17)よりなっている。このようにしてゲイト電極を"1"、ソースまたはドレインを"1"とすると、チャネル形成領域を電流が流れオン状態を、またそれぞれが一方または双方が"0"ならばオフ状態を作ることができた。

"1"はNチャネル型IGFでは正の0.5~10Vの電圧を、"0"は0Vまたはスレッショルド電圧

以下の電流を意味する。

Pチャネル型のIGFはその電極の極性を変えればよい。これらの論理系は第1図、第2図においてもまた以下の第3図または本発明の実施例においても同様である。

また第1図の抵抗(70)は第2図(D)、(E)および第3図(D)においてゲイトに加える電圧に無関係にS2のバルク成分の抵抗率で決められる。すなわちゲイト電極を設けない状態でS1、S2、S3を積層すればよい。またこの抵抗値はS2の抵抗率とその厚さ、基板の上にしめる面積で設計仕様に従って決めればよい。

第1図のインバータ(60)においてドライバー(61)は第2図、第3図(D)とし、さらにそのロード(64)はS3(15)、S1(12)の一方とゲイト電極(17)との連結させるエンヘンシメント型またはディプレッション型のIGFとした。

さらにこのインバータ(60)の出力は(62)よりなり、この基板上に離間して2つのIGFを積層して複合化すればよく、入力部はゲイト電極(17)に

対応して設ければよい。

第4図(A)は他の本発明のたて断面図を示したものである。すなわち基板(1)にS1(12)、S2(14)、S3(15)およびゲイト部がゲイト絶縁物(16)、ゲイト電極(17)によりなっているIGF(10)と、S1(12)でかつ電気系に連結した他部はキャパシタの一方の電極(22)を有し、かつこの他部は液晶表示の一方の電極(32)をも構成させている。すなわちS1はふたつのキャパシタの一方の電極となっている。そしてそのひとつのキャパシタは蓄積容量を大きくとり液晶表示の表示時間を長くするために用いられている。

すなわち第1図において特定のIGFがオン状態となる時間が10~100 n秒であっても、液晶パネルとキャパシタが直列に接続されているため液晶表示はその表示が1~1000 m秒も有するいわゆる残光特性をもたしめることができた。このため蓄積(ストレージ キャパシタ)が大きいと例えばTVのブラウン管に対応する平面パネルでの表示があざやかになり、かつ絵素の数が $10^4 \sim 10^5$

ケになり、それらをデジタル的にスキャンしていても他の絵素に"0"、"1"を表示しつづけることが可能になる。この蓄積容量の有効性は絵素の数が10ケ以上になった際見ている人に目のつかれを覚えさせないために有効である。

またこの蓄積容量のキャパシタはゲイト絶縁物(16)と同一材料としたことにより、同一パッジ式に何らかの新たな工程を必要とせず作ることができた。しかしこの容量を小面積で増加するため、酸化珪素ではなく窒化珪素、酸化タンタルその他強誘電体を用いてもよい。

本発明におけるS1(12)に電気的に接続されている他の電極(32)は電極穴(25)を介して設けられている。これらIGF(10)上にポリイミドまたはPIQ等の層間絶縁物を1~3 μの厚さに設け、それを選択的にフォトリソグラフィ技術により設ければよい。この電極(32)がひとつの絵素の大きさを決定する。カリキュリタ等においては0.1~5 μmまたはく形を有している。しかし第1図の如き走査型的方式において、1~50 μmをマ

トリプルスタックとして500×500とした。液晶表示部(31)はこの基板上に半導体装置電極を設けた一方の極と他方をITO等の透明電極(27)を有するガラス板(28)とを1~20 μ mの間隔を有せしめて対応させそこに例えばネマチック型の液晶(26)を注入して設けた。

またディスプレイをカラー表示してもよい。さらに例えばこれらの絵素が三重に重ね合わされてもよい。そして赤緑青の3つの要素を交互に配列せしめればよい。

第4図(A)が蓄積キャパシタと液晶キャパシタで等価回路にて示される液晶とを並列に連結して設けたのに対し、第4図(B)は直列に設けたものである。

すなわちS1(12)に電気的に連結した一方の電極(22)上に誘電膜(23)、他方の電極(24)、さらにこの電極(24)に連結した第2の液晶キャパシタ(31)の一方の電極(32)が開口(25)を介して連結しており、この電極(32)に対応して透明電極による対抗電極(27)が液晶(26)の誘電体をはさんで設けら

る。熱エネルギーに対して安定なことは本発明の他の特徴である。

特にSASは10~100Åの大きなマイクロクリスタル構造の格子歪を有する非単結晶半導体であり、その製造には500kHz~3GHzの誘導エネルギーを使っても温度が300℃までで充分であり、加えてその電子・ホール拡散長がアモルファス硅素の100~10³倍も大きいという物性的特性を有している。かかる非単結晶半導体を基板上に積層する構造により、IGFを設けたこと、加えてここを電流がたて方向に流れるためチャンネル長が0.1~1 μ mのマイクロチャンネル型IGFを高精度のフォトリソグラフィ技術を用いずにつくることができることがきわめて大きな特徴である。

さらに本発明においてIGFとしての特性はSASの特性にかんがみ、そのスレッショールト電圧(V_{th})は例えばドーパをイオン注入法で行なうのではなく、S2に添加する不純物の添加量と加える高周波パワーにより制御する点も特徴である。

る。

第4図(A)(B)で明らかな如く、本発明は基板(1)上に積設のIGFキャパシタ、抵抗または同時にサンドウィッチ構造として液晶表示の平面パネルを設けたことを特徴としている。

さらに図面より明らかな如く、上方よりの光照射に対して、IGF(10)に光が照射して"0"状態のトリックしてしまうことを防止するためこれを上方よりおおい、絵素の一方の電極(32)を設けていることを他の特徴としている。

加えて従来と異なり、絶縁基板上に完全に他の絵素とアイソレートしてIGFを積層型に設けていることはきわめて大きな特徴であり、特にこの全行程を600℃以下特に300℃以下の温度で作ることが可能であることは、このパネルが大面積としても熱歪の影響を受けにくいという大きな特徴を有している。

加えて本発明に用いた半導体は非単結晶構造を中心としており、特にSASというアモルファスと単結晶との中間構造であって、かつ600℃まで

そのため耐圧20~30V、 $V_{th}=-4\sim 4$ Vを ± 0.2 Vの範囲で制御できた。さらに同波数特性がチャンネル長が0.1~1 μ mのマイクロチャンネルのため、これまでの単結晶型の絶縁ゲイト型半導体装置の1/5~1/50を非単結晶半導体を用いたのにもかかわらず得ることができた。

また逆方向リークではあるが、第1図に示すようなS1とS2との間に窒化硅素を10~40Åの厚さに挿入することによりこのN⁺-P接合またはP⁺-N接合のリークは逆方向に10Vを加えても10mA以下であった。これは単結晶の逆方向リークに匹敵する好ましいものであった。

またS1に例えば酸素を10~30モル%添加すると、第3図に示した構造においては同様に逆方向にリークが少なく、無添加の場合に比べて1/10~1/100倍もリークが少なかった。このリークが少ないことが第1図のマトリックス構造を実施する時きわめて有効であることは当然である。

さらにこの逆方向リークはこの積層型のS1、S2、S3をとともにアモルファス硅素の半導体の

みで作った場合、逆方向バイアスを10V加えると1mA以上あったが、これをSASとすると50nAにまで下がった。それはS1、S3のPまたはN型の半導体におけるB、Pの不純物が置換型に配位し、そのイオン化率が単結晶と同じく4N以上となったことおよびその活性化エネルギーがアモルファスの場合の0.2~0.3eVより0.005~0.001eVと小さくなったことにある。

このため一度配位した不純物が積層中にアウトディフュージョンせず結果として接合がきれいにできたことによる。

すなわち本発明は積層型IGFであること、ここに非単結晶半導体を用いたこと、特にSASを用いたこと、さらにS1とS2の間の接合を明確にするためS1に酸化窒素を同時に添加し主にエネルギーバンド巾として逆耐圧を上げたこと、または絶縁または半絶縁膜を介在させたSIS接合としたことを特徴としている。

さらにかかる積層型のIGFのため従来のように高精度のフォトリソグラフィ技術を用いるこ

となし基板特に絶縁基板上に複数個のIGF、抵抗、キャパシタを作ることが可能になった。そして液晶表示ディスプレイにまで発展させることが可能となった。

本発明における半導体は珪素、絶縁体は酸化珪素または窒化珪素を用いた。しかし半導体としてゲルマニウム、InP、BP、GaAs等を用いてもよい。また非単結晶半導体ではなく単結晶半導体を、またSASではなくその結晶粒径の大きな多結晶半導体であってもよいことはいうまでもない。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による液晶電気光学装置に用いる絶縁ゲート型半導体装置、インパクタ抵抗、キャパシタまたは絶縁ゲート型半導体装置とキャパシタとを線素としたマトリックス構造の等価回路を示す。

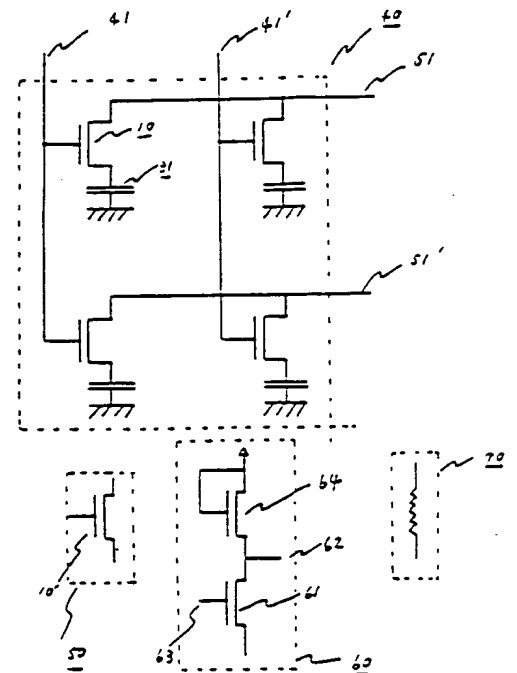
第2図、第3図は本発明による液晶電気光学装置に用いる積層型絶縁ゲート型半導体装置の工程を示すたて断面図である。

第4図は本発明の積層型絶縁ゲート型半導体装置とキャパシタまたは液晶とを一体化した平面ディスプレイを示す複合半導体のたて断面図である。

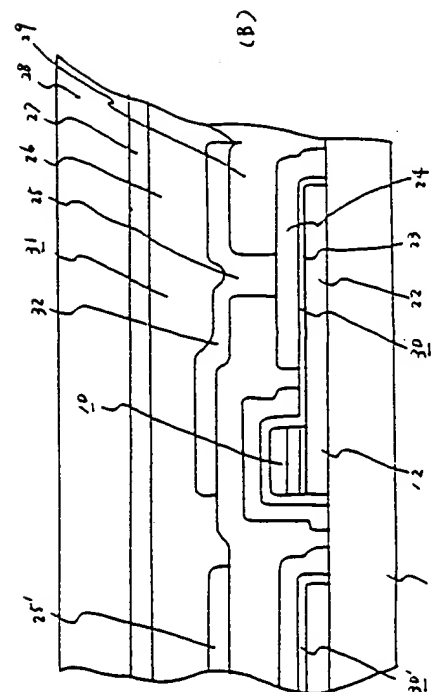
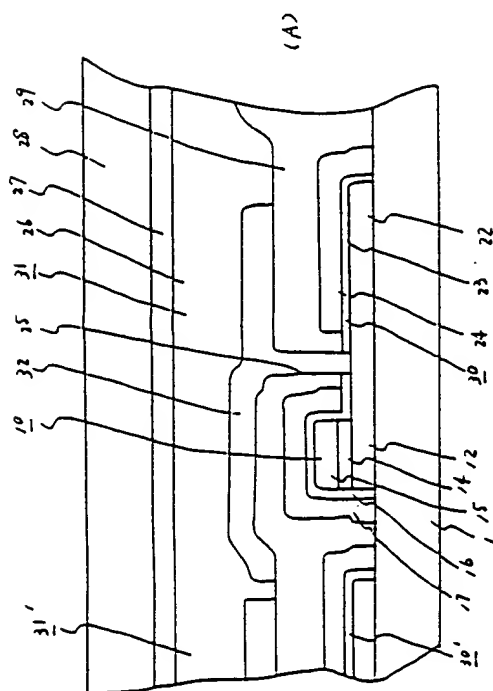
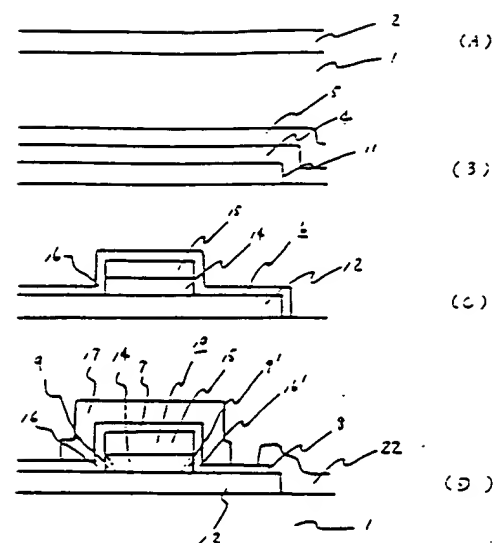
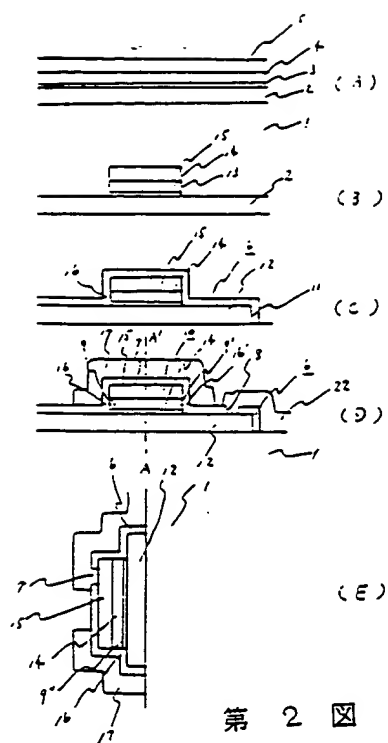
特許出願人

株式会社半導体エネルギー研究所

代表者 山 崎 昌 平



第 1 図



第 4 図